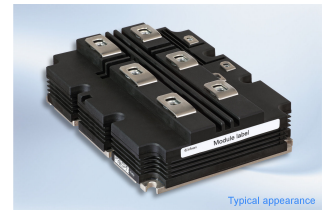


hochisolierendes Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 4500\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 1200\text{ A} / I_{CRM} = 2400\text{ A}$
 - Große DC-Festigkeit
 - Hohe dynamische Robustheit
 - Niedriges V_{CESat}
 - Trench IGBT 3
 - V_{CESat} mit positivem Temperaturkoeffizienten
 - Hohe Kurzschlussrobustheit
- Mechanische Eigenschaften
 - Große Luft- und Kriechstrecken
 - AlSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
 - Gehäuse mit erweiterten Isolationseigenschaften von 10,4kV AC 60s
 - Gehäuse mit CTI > 600
 - Isolierte Bodenplatte



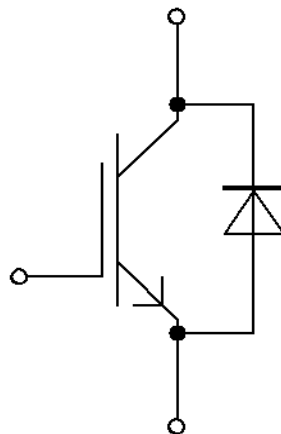
Potenzielle Anwendungen

- Hochleistungsumrichter
- Mittelspannungsantriebe
- Motorantriebe
- Multi-Level Umrichter
- Traktionsumrichter

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, Wechselrichter	4
3	Diode, Wechselrichter	5
4	Kennlinien	7
5	Schaltplan	11
6	Gehäuseabmessungen	12
7	Modul-Label-Code	13
	Änderungshistorie	14
	Disclaimer	15

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$	10.4	kV
Teilentladungs-Aussetzspannung	V_{isol}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $Q_{PD} \leq 10 \text{ pC}$	3.5	kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung	$V_{CE(D)}$	$T_{vj}=25^{\circ}\text{C}$, 100 Fit	3000	V
Material Modulgrundplatte			AlSiC	
Innere Isolation		Basisisolation (Schutzklasse 1, EN61140)	AlN	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	64.0	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	56.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	40.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	26.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		>600	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{SCE}			18		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_C=25^{\circ}\text{C}$, pro Schalter		0.12		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-55		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M6, Schraube	4.25	5.75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M4, Schraube	1.8	2.1	Nm
			M8, Schraube	8	10	
Gewicht	G			1400		g

Anmerkung: Das maximal zulässige du/dt , definiert zwischen 0,6 und $1 \times V_{ce}$, beträgt 2400V/μs.

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 **Höchstzulässige Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = -40\text{ °C}$	4500	V
			$T_{vj} = 25\text{ °C}$	4500	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	4500	
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj\text{ max}} = 150\text{ °C}$	$T_C = 80\text{ °C}$	1200	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	$t_p = 1\text{ ms}$		2400	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}			±20	V

Tabelle 4 **Charakteristische Werte**

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C = 1200\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		2.50	2.85	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		3.10	3.70	
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 105\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		5.40	6	6.60	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CE} = 2800\text{ V}$			39.5		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			0.75		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			280		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$			4.7		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 4500\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$			5	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$				400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.68\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.580		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.600		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.68\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.190		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.220		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 5.1\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		6.600		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		6.900		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 5.1\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.350		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		0.450		
Einschaltzeit (ohmsche Last)	t_{on_R}	$I_C = 500\text{ A}, V_{CE} = 2000\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.68\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.73			μs
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CE} = 2800\text{ V}, L_\sigma = 110\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.68\text{ Ω}, di/dt = 5000\text{ A/μs} (T_{vj} = 125\text{ °C})$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		4600		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		6150		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $L_\sigma = 110\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 5.1\text{ }\Omega$, $dv/dt = 2000\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	4200		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	5100		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 2800\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 10\text{ }\mu\text{s}$, $T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	6900		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT			7.40	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$		9.00		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-50		125	$^\circ\text{C}$

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		$T_{\text{vj}} = -40\text{ }^{\circ}\text{C}$	4500	V
			$T_{\text{vj}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	4500	
			$T_{\text{vj}} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	4500	
Dauergleichstrom	I_{F}			1200	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_{\text{p}} = 1\text{ ms}$		2400	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_{\text{p}} = 10\text{ ms}, V_{\text{R}} = 0\text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	570	kA^2s
Spitzenverlustleistung	P_{RQM}	$T_{\text{vj}} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		2400	kW
Mindesteinschaltdauer	t_{onmin}			10	μs

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		2.50	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		2.50	
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_R = 2800\text{ V}$, $I_F = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 5000\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1500		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	1700		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_R = 2800\text{ V}$, $I_F = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 5000\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$)	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1150		μC
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2100		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

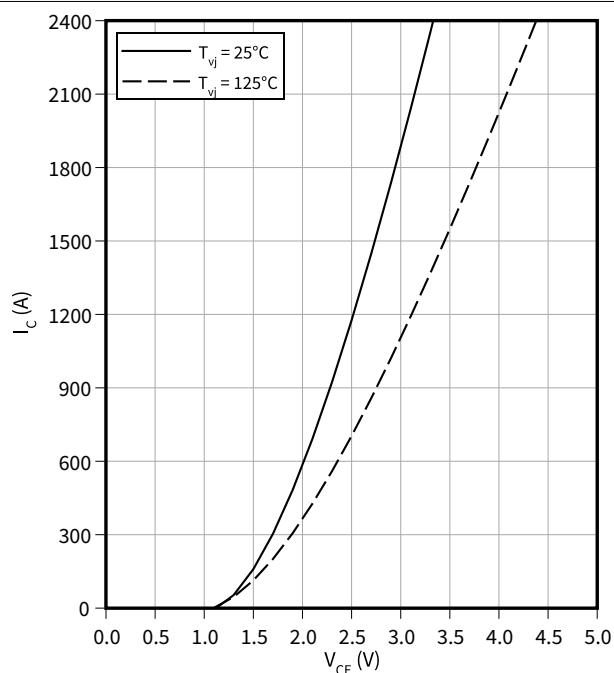
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_R = 2800\text{ V}$, $I_F = 1200\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 5000\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 125\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1750		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		3550		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				17.0	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$			14.0		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$			-50		125	°C

4 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

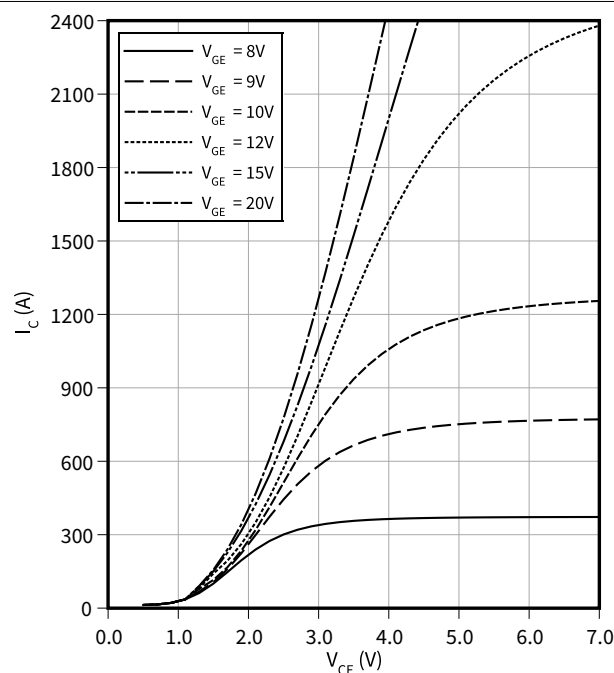
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

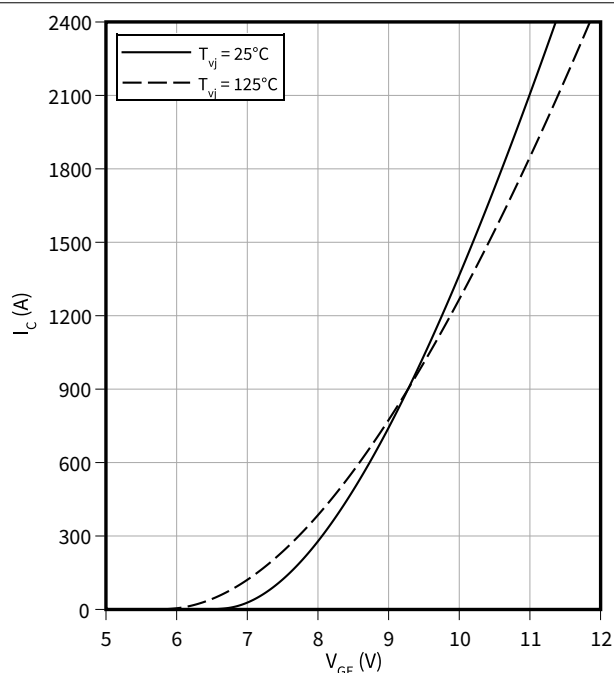
$$T_{vj} = 125 \text{ °C}$$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{GE})$$

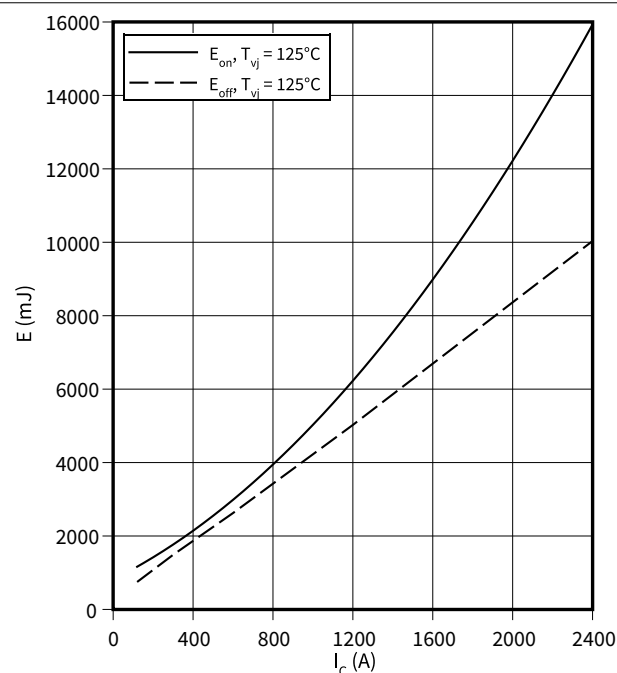
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

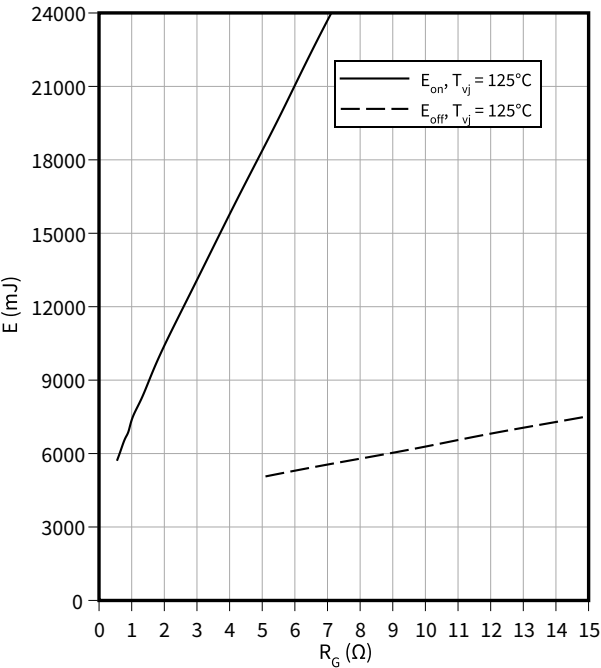
$$E = f(I_C)$$

$$V_{CE} = 2800 \text{ V}, R_{Goff} = 5.1 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.68 \text{ } \Omega, V_{GE} = -15 / 15 \text{ V}$$



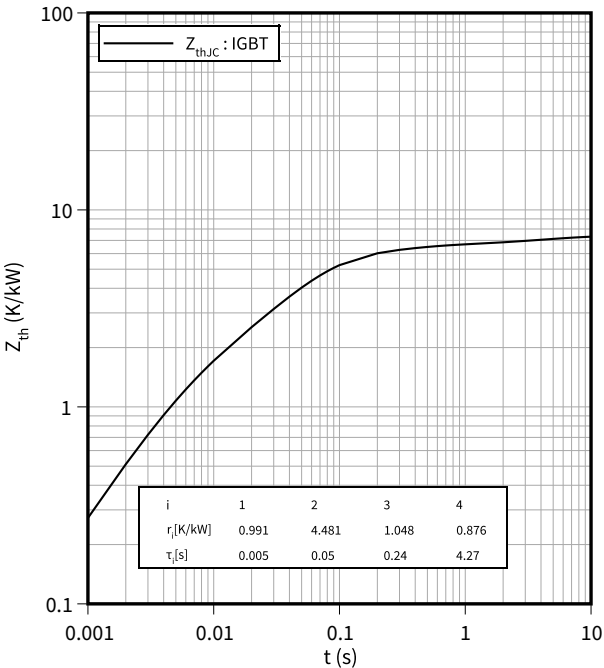
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$
 $I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CE} = 2800\text{ V}$, $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$



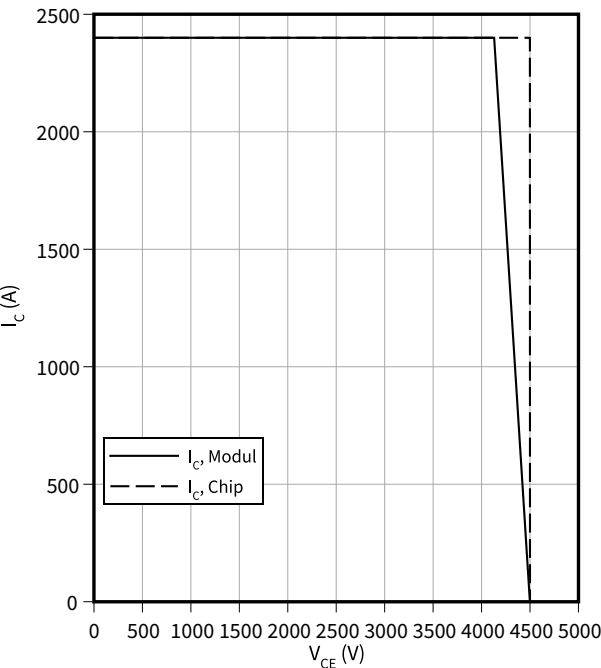
Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



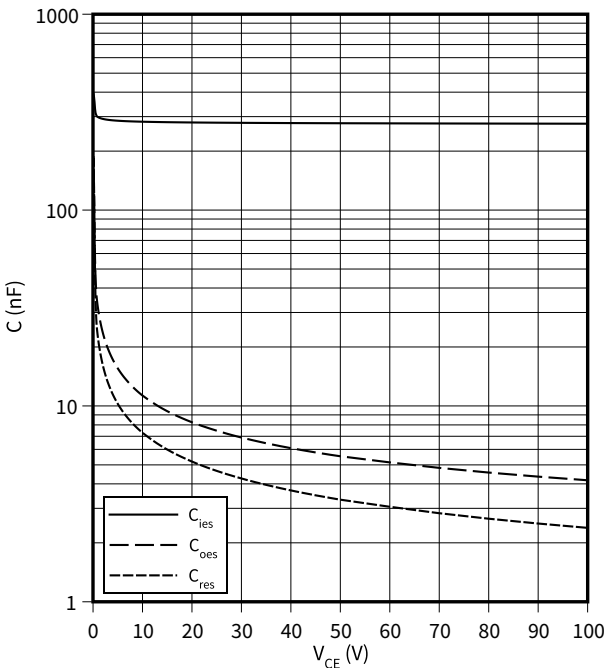
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$
 $R_{Goff} = 5.1\ \Omega$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 125\text{ °C}$



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

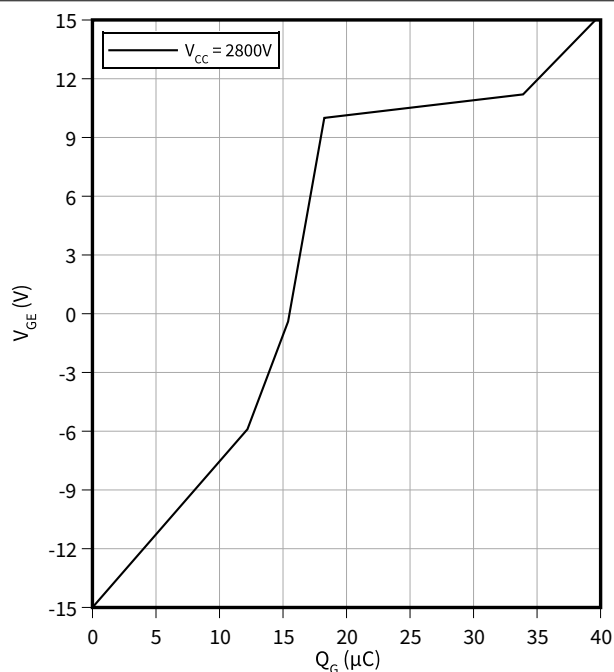
$C = f(V_{CE})$
 $f = 1000\text{ kHz}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25\text{ °C}$



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

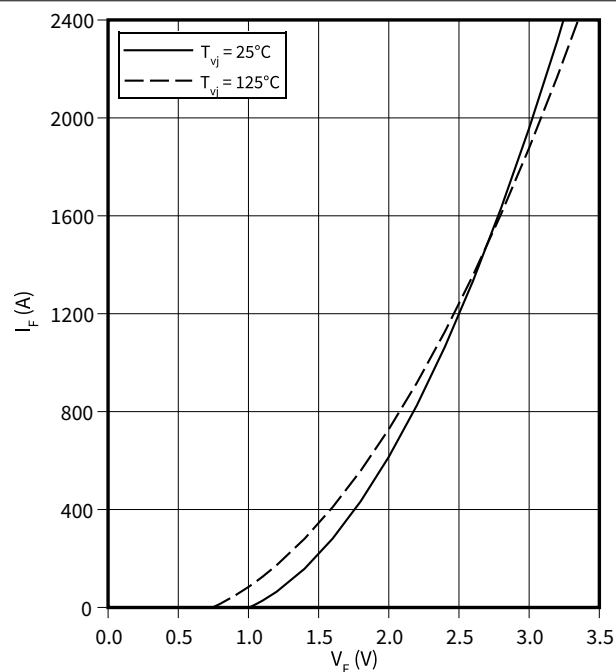
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 1200 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ \text{C}$$



Durchlasskennlinie der (typisch), Diode, Wechselrichter

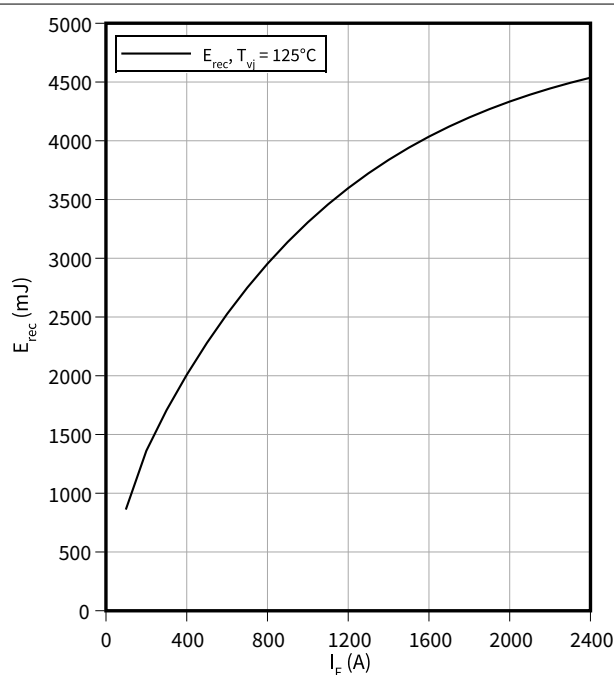
$$I_F = f(V_F)$$



Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$$E_{rec} = f(I_F)$$

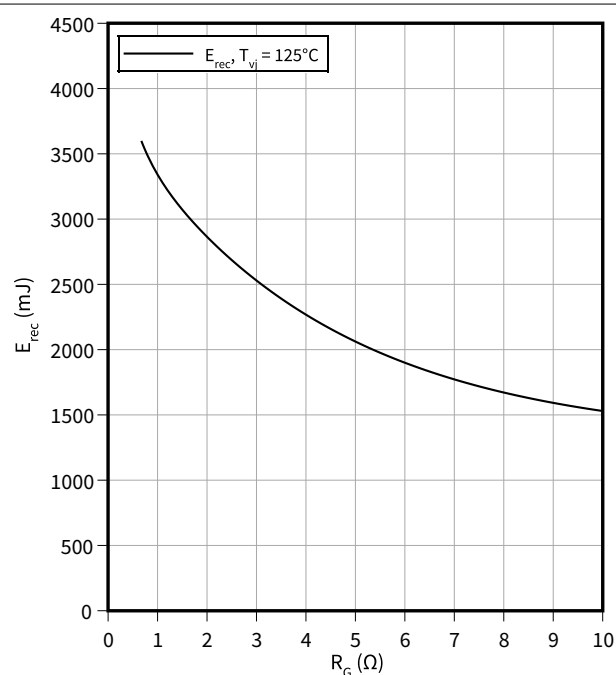
$$V_{CE} = 2800 \text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(\text{IGBT})$$



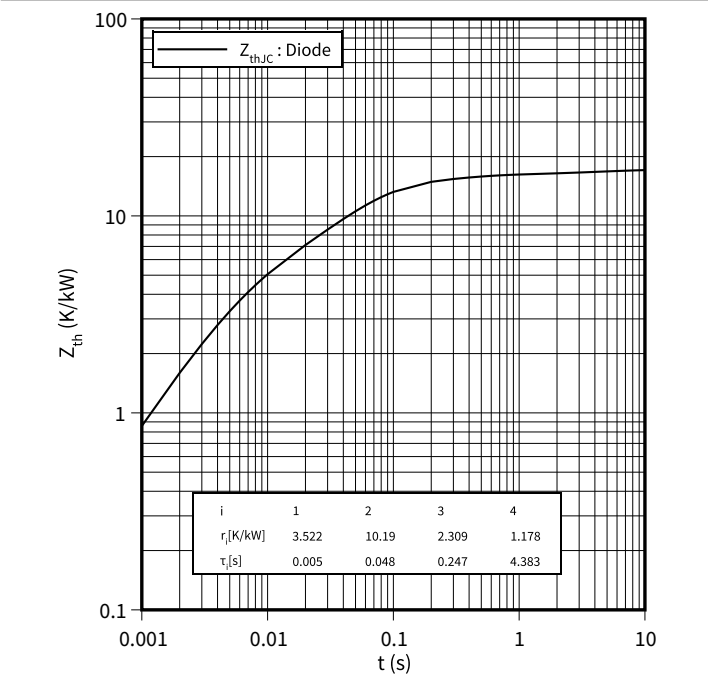
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$$E_{rec} = f(R_G)$$

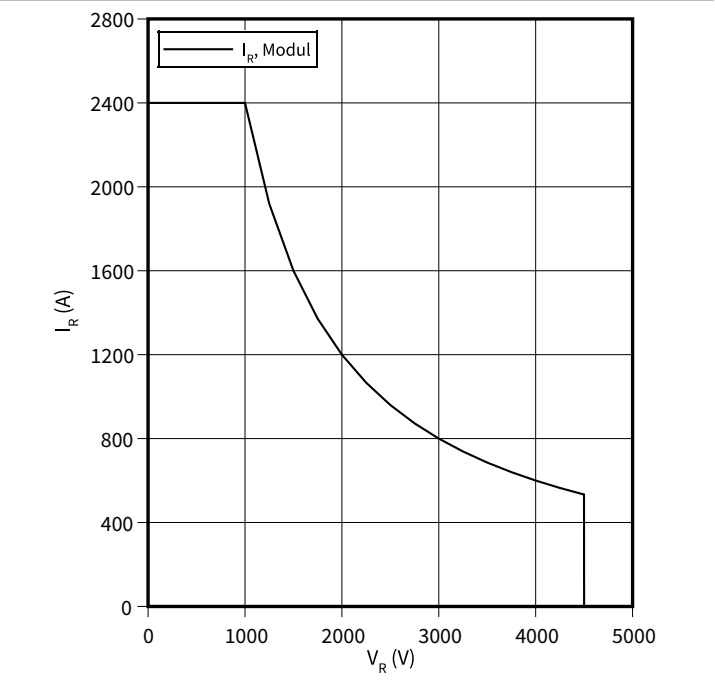
$$V_{CE} = 2800 \text{ V}, I_F = 1200 \text{ A}$$



Transienter Wärmewiderstand , Diode, Wechselrichter
 $Z_{th} = f(t)$



Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Wechselrichter
 $I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 125\text{ °C}$



5 Schaltplan

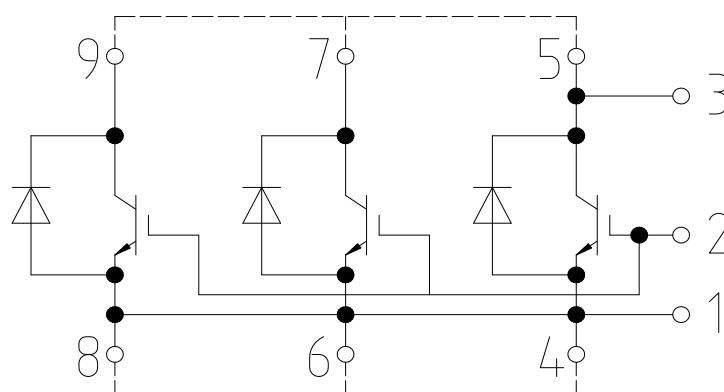


Abbildung 1

6 Gehäuseabmessungen

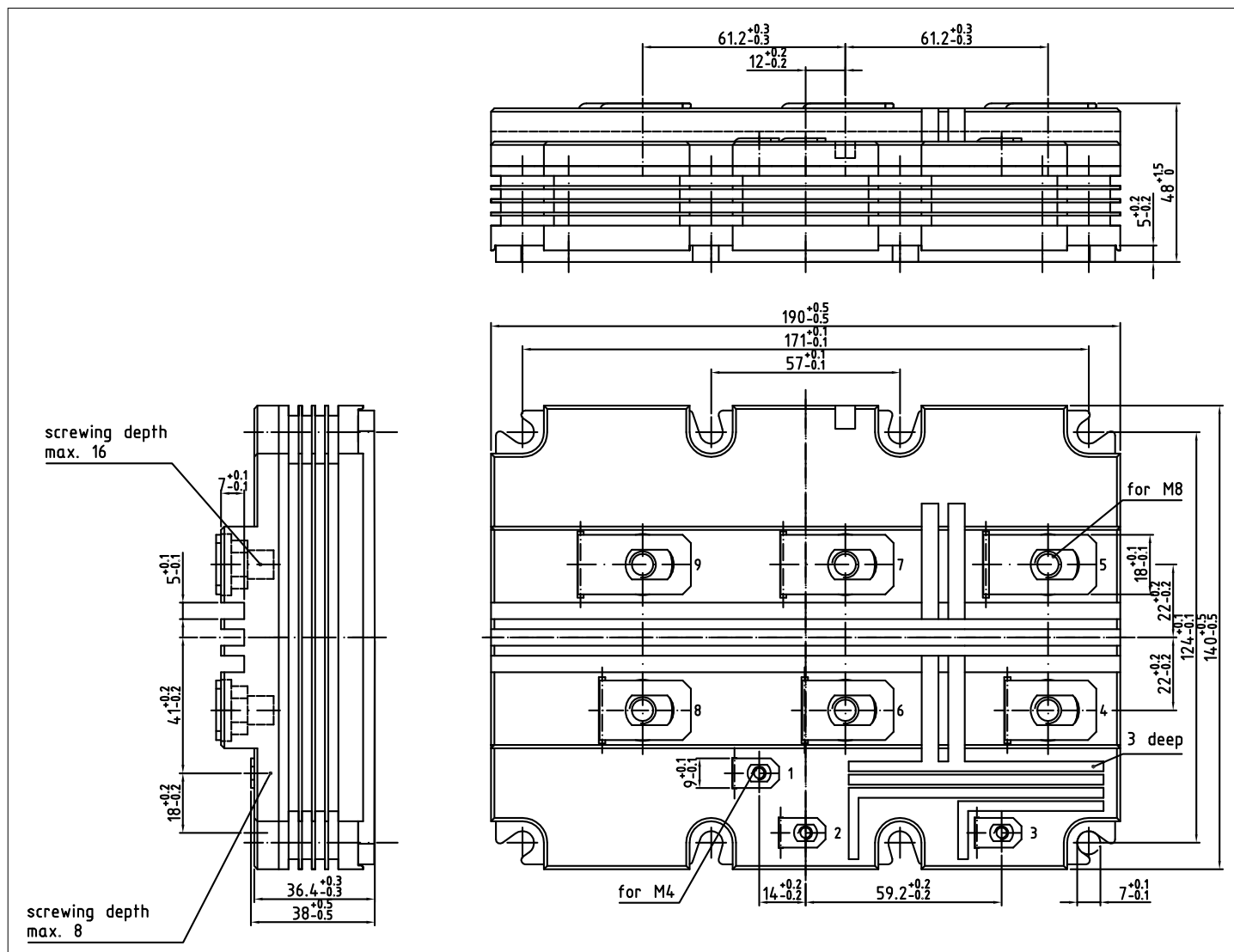


Abbildung 2

7 Modul-Label-Code



Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	<div> 71549142846550549911530</div> <div> 71549142846550549911530</div>		

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
V1.0	2011-07-15	Target datasheet
V1.1	2011-10-10	Target datasheet
V1.2	2011-10-21	Target datasheet
V1.3	2012-05-24	Target datasheet
V1.4	2012-06-14	Target datasheet
V1.5	2012-09-07	Target datasheet
V2.0	2013-04-02	Preliminary datasheet
V3.0	2013-05-27	Final datasheet
V3.1	2016-08-30	Final datasheet
V3.2	2018-01-15	Final datasheet
V3.3	2019-08-23	Final datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.10	2021-10-27	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2021-10-27

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2021 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any
aspect of this document?**

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-AAW934-012**

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.